

## ИСКУССТВЕННЫЕ ГИРОТРОПНЫЕ СРЕДЫ

Я. Б. Файнберг, Н. А. Хижняк

Распространение электромагнитных волн в гиротропных средах характеризуется, как известно, рядом важных особенностей, и представляют интерес как для электроники сверхвысоких частот, так и для физической оптики. В гиротропных средах волны испытывают круговое двойное преломление и поэтому фазовая скорость распространения волн с круговой поляризацией зависит от направления вращения вектора поляризации. В итоге линейно-поляризованное излучение испытывает вращение плоскости поляризации.

Среди естественных диэлектриков имеется ряд веществ, обладающих гиротропными свойствами (кварц, раствор сахара и другие). Это так называемые естественные оптически активные вещества. Как показали исследования Борна и Озенна [1], свойства гиротропности в них связаны с определенным характером симметрии молекулы (отсутствие центра и плоскости симметрии), а величина угла поворота плоскости поляризации линейно поляризованной волны пропорциональна  $\frac{a}{\lambda}$ , где  $a$  — размер молекулы,  $\lambda$  — длина волны. По этой причине в качестве рассеивающих центров искусственного диэлектрика выбираются пары эллипсоидов с некомпланарными осями. Очевидно, что такая система не имеет ни центра, ни плоскости симметрии. Кроме того, все вычисления проведены с точностью до величин порядка  $(l/\lambda)$  включительно. Здесь  $l$  — расстояние между центрами эллипсоидов.

Тензор диэлектрических проницаемостей гиротропной среды наряду с диагональными вещественными элементами содержит также чисто мнимые недиагональные члены, которые описывают не поглощение в среде, так как  $\epsilon_{ik} = \epsilon_{ki}$ , а вращение плоскости поляризации. Поэтому в настоящей работе исследование гиротропных свойств искусственного диэлектрика сводится к выводу выражений для тензоров диэлектрических и магнитных проницаемостей и к вычислению мнимых недиагональных элементов.

Согласно [2], средние электрическое и магнитное поля в рассматриваемом диэлектрике определяются следующими выражениями, справедливыми с точностью до  $(S/\lambda)$ , где  $S$  — размер элементарной ячейки, охватывающей отдельную рассеивающую пару

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{E} &= -ik \mu_1 \left\{ \mathbf{H} + \frac{4\pi}{Q} \hat{\rho}_1 \mathbf{H}_{\text{возд}}' + \frac{4\pi}{Q} \hat{P}_2 \mathbf{H}_{\text{возд}}'' \right\}, \\ \text{rot } \mathbf{H} &= ik \epsilon_1 \left\{ \mathbf{E} + \frac{4\pi}{Q} \hat{\beta}_1 \mathbf{E}_{\text{возд}}' + \frac{4\pi}{Q} \hat{g}_2 \mathbf{E}_{\text{возд}}'' \right\}.\end{aligned}\quad (1)$$

Здесь  $\hat{g}_1$ ,  $\hat{g}_2$  и  $\hat{\delta}$  — матрицы, характеризующие анизотропное рас-  
сеяние электрического и магнитного полей на первом и втором эллип-  
соидах соответственно,  $\epsilon_1$  и  $\mu_1$  — диэлектрическая и магнитная прони-  
цаемости окружающей среды,  $\Omega$  — объем элементарной ячейки решетки,  
а  $E'_{\text{возб}}$ ,  $H'_{\text{возб}}$ ,  $E''_{\text{возб}}$  и  $H''_{\text{возб}}$  — электрические и магнитные поля, возбуж-  
дающие первый и второй эллипсоиды пары.

Каждый из эллипсоидов возбуждается полем, состоящим из внеш-  
него поля, созданного всеми окружающими парами частиц, совместно  
с полем падающей на диэлектрик волны, и поля соседнего эллипсоида

$$\begin{aligned} E'_{\text{возб}} \left( r_n - \frac{1}{2} I \right) &= E_{\text{возб}} \left( r_n - \frac{1}{2} I \right) + E_{21}, \\ E''_{\text{возб}} \left( r_n - \frac{1}{2} I \right) &= E_{\text{возб}} \left( r_n - \frac{1}{2} I \right) + E_{12}. \end{aligned} \quad (2)$$

Поле, созданное всеми окружающими парами частиц совместно с  
полем падающей волны  $E_{\text{возб}} \left( r_n - \frac{1}{2} I \right)$  в точке, расположенной по-  
средине отрезка, который соединяет центры эллипсоидов, можно выра-  
зить через среднее поле в среде и поля, возбуждающие каждый эллип-  
соид в отдельности

$$E_{\text{возб}} (r_n) = E(r_n) - \frac{1}{\Omega} \hat{\delta} \hat{g}_1 E'_{\text{возб}} - \frac{1}{\Omega} \hat{\delta} \hat{g}_2 E''_{\text{возб}}, \quad (3)$$

где  $\hat{\delta}$  — матрица, учитывающая геометрию решетки [2]. Поле, действующее  
со стороны второго эллипсоида на первый, выражается через поле, воз-  
буждающее второй эллипсоид

$$E_{21} = \pi \hat{g}_2 E'_{\text{возб}} \left( r + \frac{1}{2} I \right) e^{i\theta}, \quad (4)$$

где  $\hat{\pi}$  — тензор дипольных моментов, компоненты которого зависят лишь  
от расстояния между центрами эллипсоидов пары и их взаимной ориен-  
тации, а  $\theta \sim (l/\lambda)$  — фазовый сдвиг, обусловленный конечностью рас-  
стояния между центрами эллипсоидов. Аналогично находим, что поле,  
действующее со стороны первого эллипсоида на второй, равно

$$E_{12} = \pi \hat{g}_1 E''_{\text{возб}} \left( r - \frac{1}{2} I \right) e^{-i\theta}. \quad (5)$$

Заметим, что элементы произведения матриц  $\hat{\pi}$  и  $\hat{g}$  пропорциональны  
отношению  $(v/v_1) = \eta$ , объема эллипсоида  $v$  к объему куба  $v_1$ , по-  
строенного на отрезке, соединяющем центры эллипсоидов, как на ребре.  
Предполагая это отношение малым и ограничиваясь лишь первыми сте-  
пенями величины  $\eta$ , для  $E'_{\text{возб}}$  и  $E''_{\text{возб}}$  будем иметь следующие выраже-  
ния:

$$E'_{\text{возб}} (r) = \left( 1 + \pi \hat{g}_2 e^{i\theta} \right) E_{\text{возб}} (r) \quad (6)$$

$$E''_{\text{возб}} (r) = \left( 1 + \pi \hat{g}_1 e^{-i\theta} \right) E_{\text{возб}} (r). \quad (7)$$

Подставив (6) и (7) в (3), находим

$$E_{\text{возб}} = \left\{ 1 + \frac{1}{\Omega} \hat{\delta} \left( \hat{g}_1 + \hat{g}_2 \right) \right\}^{-1} E, \quad (8)$$

а в (6), (7) и (8) выражаем  $E'_{\text{возд}}$  и  $E''_{\text{возд}}$  через  $E$ . Следовательно, уравнения (1) принимают вид ( $\theta \ll 1$ )

$$\begin{aligned} \text{rot } E &= -ik\mu_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} \left[ (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (\hat{p}_1 \pi \hat{p}_2 + \hat{p}_2 \pi \hat{p}_1) + i \sin \theta (\hat{p}_1 \pi \hat{p}_2 - \hat{p}_2 \pi \hat{p}_1) \right] \times \right. \\ &\quad \left. \times \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) \right]^{-1} \right\} H, \\ \text{rot } H &= ik\epsilon_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} \left[ (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + (\hat{g}_1 \pi \hat{g}_2 + \hat{g}_2 \pi \hat{g}_1) + i \sin \theta (\hat{g}_1 \pi \hat{g}_2 - \hat{g}_2 \pi \hat{g}_1) \right] \times \right. \\ &\quad \left. \times \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) \right]^{-1} \right\} E, \end{aligned}$$

т. е. имеют вид уравнений Максвелла в среде, характеризуемой тензором диэлектрических проницаемостей,

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon} &= \epsilon_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} \left[ (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) + (\hat{g}_1 \pi \hat{g}_2 + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \hat{g}_2 \pi \hat{g}_1) + i \theta \hat{\tau}_s \right] \cdot \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) \right]^{-1} \right\} \end{aligned} \quad (9)$$

и тензором магнитных проницаемостей

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= \mu_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} \left[ (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) + (\hat{p}_1 \pi \hat{p}_2 + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \hat{p}_2 \pi \hat{p}_1) + i \theta \hat{\tau}_\mu \right] \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) \right]^{-1} \right\}. \end{aligned} \quad (10)$$

Из этих выражений следует, что минимая часть тензоров диэлектрических и магнитных проницаемостей обязана тензорам

$$\begin{aligned} \hat{\tau}_s &= \hat{g}_1 \pi \hat{g}_2 - \hat{g}_2 \pi \hat{g}_1, \\ \hat{\tau}_\mu &= \hat{p}_1 \pi \hat{p}_2 - \hat{p}_2 \pi \hat{p}_1. \end{aligned} \quad (11)$$

Так как тензоры  $\hat{g}_1$ ,  $\hat{g}_2$  и  $\pi$  являются симметричными, то

$$\begin{aligned} (\hat{\tau}_s)_{lk} &= g_{im}^{(1)} \cdot \pi_{ml} g_{jk}^{(2)} - g_{im}^{(2)} \pi_{ml} g_{jk}^{(1)} = \\ &= - (g_{kl}^{(1)} \pi_{lm} g_{mi}^{(2)} - g_{kl}^{(2)} \pi_{lm} g_{mi}^{(1)}) = - (\hat{\tau}_s)_{kl}. \end{aligned} \quad (12)$$

Таким образом, тензор  $\hat{\tau}_s$  антисимметричен. Пренебрегая в (9) и (10) малыми членами, тензоры  $\hat{\epsilon}$  и  $\hat{\mu}$  можно представить в следующем виде:

$$\hat{\epsilon} = \epsilon_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{g}_1 + \hat{g}_2) \right]^{-1} + i \theta \hat{\tau}_s \right\}, \quad (13)$$

$$\hat{\mu} = \mu_1 \left\{ 1 + \frac{4\pi}{\Omega} (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) \left[ 1 + \frac{1}{\Omega} \delta (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) \right]^{-1} + i \theta \hat{\tau}_\mu \right\}, \quad (14)$$

из которых следует, что рассматриваемая среда является гиротропной, если только не все компоненты тензора  $\hat{\tau}_s$  равны нулю.

Первые слагаемые в (13) и (14) представляют собой обычные тензоры диэлектрических и магнитных проницаемостей искусственного диэлектрика, образованного частицами двух сортов, и поэтому в дальнейшем рассматриваться не будут.

Вторые слагаемые пропорциональны  $\vartheta$ , т. е. отношению расстояния между центрами эллипсоидов к длине волны. По величине  $\vartheta$  равно

$$\vartheta = kl \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \cos(\hat{In}),$$

где  $(\hat{In})$  — угол между направлением распространения волны и прямой, соединяющей центры эллипсоидов. Следовательно, гиротропные свойства рассматриваемой среды зависят от направления распространения волны. Независимость гиротропных свойств от направления распространения волны может быть лишь в средах с хаотически ориентированными рассеивающими центрами.

Чтобы выяснить связь компонент тензора  $\tau$  с симметрией рассеивающего центра, рассмотрим конкретный пример. Пусть прямая, соединяющая центры эллипсоидов, параллельна оси  $OX$ . Тогда единственной, отличной от нуля компонентой тензора  $\pi$ , будет  $(\hat{\pi})_{11} = (2/l^3)$ . Предположим также, что оси первого эллипса совпадают с осями координат, тогда как оси второго повернуты на некоторые углы, характеризуемые угловыми косинусами  $a_{ik}$ . В таком случае отличные от нуля компоненты тензора  $\tau_3$  равны

$$\tau_1 = (\hat{\tau}_3)_{12} = -(\hat{\tau}_3)_{21} = \frac{2}{l^3} g_{11} (\alpha_{11} \alpha_{21} g_{11} + \alpha_{12} \alpha_{22} g_{22} + \alpha_{13} \alpha_{23} g_{33}), \quad (15)$$

$$\tau_2 = (\hat{\tau}_3)_{13} = -(\hat{\tau}_3)_{31} = \frac{2}{l^3} g_{11} (\alpha_{11} \alpha_{31} g_{11} + \alpha_{12} \alpha_{32} g_{22} + \alpha_{13} \alpha_{33} g_{33}).$$

Если второй эллипс просто повернет на некоторый угол относительно оси  $OX$ , то  $\alpha_{12} = \alpha_{13} = 0$  и гиротропные свойства отсутствуют; при таком повороте система двух эллипсоидов имеет центр симметрии. Если же второй эллипс повернет на некоторый угол относительно прямой, лежащей в плоскости  $YOZ$ , то центр симметрии отсутствует. Пусть этой прямой является ось  $OZ$ . Тогда  $\tau_1$  и  $\tau_2$  имеют вид

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{2}{l^3} g_{11} (\alpha_{11} \alpha_{21} g_{11} + \alpha_{12} \alpha_{22} g_{22}), \\ \tau_2 &= 0. \end{aligned} \quad (16)$$

Когда  $\alpha_{12} = 0$ , то гиротропные свойства снова отсутствуют. В этом случае система двух эллипсоидов имеет плоскость симметрии.

Следовательно, искусственный диэлектрик, образованный правильной решеткой рассеивающих частиц, обладает гиротропными свойствами, если только эти пары частиц не имеют плоскости и центра симметрии. Величина угла поворота вектора поляризации плоской волны, распространяющейся в такой среде, пропорциональна параметру  $l/\lambda$ .

По аналогии с молекулярной оптикой тензоры  $\tau_3$  и  $\tau_m$ , являющиеся асимметричными тензорами второго ранга, можно представить через два вектора  $s_1$  и  $s_2$  и записать связь электрической индукции с напряженностью электрического поля в виде

$$\mathbf{D} = \hat{\epsilon} \hat{\mathbf{E}} + i\vartheta [s_1 \mathbf{E}].$$

Для магнитного поля имеем

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} + i\vartheta [\mathbf{s}_2 \mathbf{H}].$$

Векторы  $\vartheta \mathbf{s}_1$  и  $\vartheta \mathbf{s}_2$  называются электрическим и магнитным векторами гирации.

В заключение авторы выражают благодарность И. М. Лифшицу за ценные дискуссии.

#### Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Волькенштейн, Молекулярная оптика, Гостехтеориздат, М., 1951.
2. Н. А. Хижняк, ЖТФ, 27, 2006, 1957.